

文部科学省グローバル COE プログラム

「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」

平成 21 年度第 8 回ミニセミナー

日時：平成 21 年 7 月 13 日 (月) 17:00-18:30

場所：大阪大学 吹田キャンパス

電気系メモリアルホール (E1-115)

講師：井上 真雄 先生

所属：(株) ルネサス テクノロジ 生産本部、技術開発統括部

講演題目：

「先端 SoC 用 High-k/Metal ゲート開発の現状と今後の動向」

講演概要：

先端 SoC デバイス向けに開発してきた High-k/Metal(高誘電率 / メタル) ゲートの現状を、これまで用いられてきた Si 酸化膜からの変遷と合わせ報告する。さらに酸化膜換算膜厚 $EOT < 1\text{nm}$ が要求される次世代デバイスに向けた最新の業界動向についても紹介する。



問合せ先：青木秀充准教授

大阪大学大学院工学研究科電気電子情報工学専攻

Emailto: aoki@steem.eei.eng.osaka-u.ac.jp

主催：大阪大学グローバル COE 「次世代電子デバイス教育研究開発拠点」